

## Порядок учёта индивидуальных достижений поступающих при приёме на обучение

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение, **не позднее 6 августа 2025 г.**

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивидуальных достижений, в соответствии с пунктом 3.3. Правил.

2. При приеме на обучение в аспирантуру Самарского университета начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:

Вид индивидуального достижения	Подтверждающие документы	Начисляемый балл	Максимальная сумма баллов
Публикация, - опубликованная в изданиях, включенных в перечень ВАК; - опубликованная в изданиях, индексируемая в международных базах данных Scopus или Web of Science	Для начисления абитуриенту дополнительных баллов за статью (Scopus, Web of Science, РИНЦ, ВАК), должны быть предоставлены: <ul style="list-style-type: none"> <li>• титульный лист журнала, где была опубликована статья,</li> <li>• первый лист статьи (где указан(ы) автор(ы), название статьи),</li> <li>• подтверждение индексируемости статьи →</li> </ul>	1	6
Публикация, опубликованная в изданиях, включенных в РИНЦ		0,2	1
Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец/свидетельство	Копия соответствующих документов, удостоверяющих авторство полученных охранных документов на результат интеллектуальной деятельности	1	2
Диплом о высшем образовании и о квалификации с отличием	Копия диплома	0,5	0,5
Наличие рекомендации государственной экзаменационной комиссии к поступлению в аспирантуру	Копия протокола государственной экзаменационной комиссии	1	1
Победитель или призер всероссийского этапа Всероссийских студенческих олимпиад (ВСО) в соответствии с направлением подготовки аспирантуры	Копия диплома или сертификата победителя, или призера ВСО	1	2

Вид индивидуального достижения	Подтверждающие документы	Начисляемый балл	Максимальная сумма баллов
Медалист, победитель, призер Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»	Копия утвержденных списков победителей и призеров	2	2
Победитель или призер Всероссийского инженерного конкурса (ВИК)	Копия диплома победителя или призера ВИК	2	2

Примечания:

1 Добавление баллов за каждое индивидуальное достижение проводится только при представлении подтверждающих документов.

2 Баллы за индивидуальные достижения засчитываются при условии соответствия наименованию группы научных специальностей, на которую подаются документы, конкурсной группе (за исключением баллов, полученных за диплом о высшем образовании и о наличии рекомендации государственной экзаменационной комиссии).

3 Статьи, опубликованные в издании, индексируемом в международных базах данных Scopus и Web of Science, а также включенном в перечень ВАК и/или РИНЦ, учитываются не более одного раза, причем выбор предпочтительного вида индивидуального достижения остается на усмотрение поступающего.

➡ Для начисления абитуриенту дополнительных баллов за статью (Scopus, Web of Science, РИНЦ, ВАК), нужно предоставить распечатку скрина с сайта scopus.com, elibrary.ru, webofscience.com, для каждой учитываемой статьи

1) В распечатке должна быть следующая информация (Приложение 1):

- ФИО автора,
- название статьи,
- название журнала,
- подтверждение включения статьи/журнала в РИНЦ/ВАК/Scopus/Web of Science

2) Если сама статья не индексируется, но журнал, в котором опубликована статья, включен в базу РИНЦ/ВАК/Scopus/Web of Science, то помимо скрина статьи нужно приложить скрин журнала с соответствующего сайта (scopus.com, elibrary.ru, webofscience.com), с подтверждением включения журнала в соответствующую базу (Приложение 2).

3) Для статей, индексируемых в базе Scopus, необходимо

- приложить распечатку из личного кабинета сайта scopus.com, где будет видно ФИО автора и список статей (Приложение 3)
- приложить распечатку из вкладки Сведения об источнике, с информацией «Годы охвата Scopus» для каждого журнала, где опубликованы статьи (Приложение 4)



НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ  
БИБЛИОТЕКА  
**LIBRARY.RU**



### Вход

IP-адрес компьютера:

91.222.128.24

Название организации:

Самарский национальный  
исследовательский  
университет им. акад. С.П.  
Королева

Имя пользователя:

Пароль:

Вход

- Запомнить меня
- Правила доступа
  - Регистрация
  - Забыли пароль?
  - Вход через Вашу организацию

КОРЗИНА



## ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ

eLIBRARY ID: 46500007

EDN: YKWMW

DOI: 10.18469/1810-3189.2021.24.2.68-72

### ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕРМАНИЕВЫХ МДП-СТРУКТУР С ФТОРИДАМИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

САЧУК Н.В.<sup>1</sup>, ШАЛИМОВА М.Б.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34

Тип: статья в журнале - научная статья Язык: русский

Том: 24 Номер: 2 Год: 2021 Страницы: 68-72

УДК: 53.097

ЖУРНАЛ:

ФИЗИКА ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Учредители: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева  
ISSN: 1810-3189

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

МДП-СТРУКТУРА, ФТОРИДЫ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАТВОРНЫЙ ДИЭЛЕКТРИК, ДЕГРАДАЦИЯ ДИЭЛЕКТРИКА

АННОТАЦИЯ:

Исследовались электрические свойства МДП-структур с фторидами редкоземельных элементов на подложках германия для анализа возможности использования данных материалов в качестве затворных диэлектриков устройств. Структуры изучаются также с точки зрения оценки деградации их электрофизических свойств под действием электрических полей  $\sim 108$  В/м, которые действуют на диэлектрик в процессе электроформовки, поскольку МДП-структуры с фторидами редкоземельных элементов обладают свойством бистабильного переключения. Исследования вольт-амперных и вольт-емкостных характеристик показывают, что все структуры имеют примерно одинаковое значение плотности поверхностных состояний на границе раздела фторид редкоземельного элемента / Ge. Токи утечки в МДП-структурах с пленкой TmF<sub>3</sub> и SmF<sub>3</sub> меньше, чем в МДП-структурах с пленкой NdF<sub>3</sub> большей толщины. Также не наблюдается эффекта уменьшения плотности тока при использовании двойной пленочной структуры CeF<sub>3</sub>/DyF<sub>3</sub>. Наиболее перспективным материалом с малым током утечки при довольно высоком значении диэлектрической проницаемости в германиевых МДП-структурах является тонкопленочный фторид самария.

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- Входит в РИНЦ®: да
- Входит в ядро РИНЦ®: нет
- Норм. цитируемость по журналу:
- Норм. цитируемость по направлению:
- Тематическое направление: Physical sciences and astronomy
- Рубрика ГРНТИ: Физика
- Цитирований в РИНЦ®: 0
- Цитирований из ядра РИНЦ®: 0
- Импакт-фактор журнала в РИНЦ®: 0,223
- Дециль в рейтинге по направлению:

АЛЬТМЕТРИКИ:

- Просмотров: 9 (4)
- Загрузок: 2 (1)
- Включено в подборки: 2
- Всего оценок: 0
- Средняя оценка:
- Всего отзывов: 0

ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

ELECTROPHYSICAL CHARACTERISTICS OF GERMANIUM MIS STRUCTURES WITH RARE-EARTH ELEMENT FLUORIDES

SACHUK NATALIA V.<sup>1</sup>, SHALIMOVA MARGARITA B.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Samara National Research University, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russia



НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ  
БИБЛИОТЕКА  
**eLIBRARY.RU**



ПОИСК

ВХОД

IP-адрес компьютера:  
91.222.128.24

Название организации:  
Самарский национальный  
исследовательский  
университет им. акад. С.П.  
Королева

Имя пользователя:

eLIBRARY ID: 9210

Язык описания: русский

**ФИЗИКА ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ? Тип сериального издания: периодическое издание
- ? Элементы сериального издания: выпуск журнала
- ? Назначение издания: научное
- ? Способ распространения: в печатном и электронном виде
- ? Доступ к полным текстам: все выпуски в открытом доступе
- ? Основной источник финансирования: учредитель
- ? Мультидисциплинарность: не является мультидисциплинарным
- ? Язык публикаций: русский, английский

УЧРЕДИТЕЛИ:

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара)  
Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева (Самара)

РЕДАКЦИЯ:

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара)

ИЗДАТЕЛЬСТВО:

Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева (Самара)

РАСПРОСТРАНТЕЛЬ:

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара)

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕДАКЦИИ:

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ:

<span style="color: red;">?</span> ISSN печатной версии: 1810-3189	<span style="color: red;">?</span> ISSN Электронной версии:
<span style="color: red;">?</span> Число выпусков в год: 4	<span style="color: red;">?</span> Год основания: 1998
<span style="color: red;">?</span> Число статей в выпуске: 12	<span style="color: red;">?</span> Период выпуска: 1998-...
<span style="color: red;">?</span> Число страниц в выпуске: 90	<span style="color: red;">?</span> Архив на eLIBRARY.RU: 2007-2022
<span style="color: red;">?</span> Всего статей на eLIBRARY.RU: 1019	<span style="color: red;">?</span> Всего выпусков на eLIBRARY.RU: 94
<span style="color: red;">?</span> Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-68199 от 27.12.2016	

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА:

Журнал «Физика волновых процессов и радиотехнические системы» – периодический теоретический и научно-практический журнал, в котором публикуются результаты оригинальных научных исследований по разделам: Радиоп физика, Оптика, Радиотехника, Антенны, СВЧ устройства

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Москва)  
 Яцшен Валерий Васильевич   
 Волгоградский государственный университет (Волгоград)  
 Яшин Алексей Афанасьевич   
 Тульский государственный университет (Тула)

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ:

<span style="color: red;">?</span> Вид: одностороннее слепое рецензирование	<span style="color: red;">?</span> Число рецензентов: 1
<span style="color: red;">?</span> Доля отклоненных рукописей: 4	<span style="color: red;">?</span> Срок публикации: 30 дней
<span style="color: red;">?</span> Рецензирование осуществляется: членами редакционной коллегии	

РУБРИКИ ГРНТИ:

290000. Физика  
470000. Электроника. Радиотехника

РУБРИКИ OECD:

103. Physical sciences and astronomy  
202. Electrical engineering, electronic engineering

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВАК:

010304. Радиофизика  
010306. Оптика  
020213. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения  
020214. Антенны, СВЧ-устройства и их технологии  
020202. Электронная компонентная база микро- и нанoeлектроники, квантовых устройств

ИНДЕКСАЦИЯ:

<span style="color: red;">?</span> eLIBRARY.RU: да (договор 356-09/2019)	<span style="color: red;">?</span> RSCI: нет
<span style="color: red;">?</span> РИНЦ: да	<span style="color: red;">?</span> ESCI: нет
<span style="color: red;">?</span> Ядро РИНЦ: нет	<span style="color: red;">?</span> Web of Science: нет
<span style="color: red;">?</span> Перечень ВАК РФ: да	<span style="color: red;">?</span> Scopus: нет
<span style="color: red;">?</span> CrossRef: да	<span style="color: red;">?</span> Префикс DOI: 10.18469/1810-3189
<span style="color: red;">?</span> DOAJ: нет	
<span style="color: red;">?</span> Базы данных:	

\* © 2000-2022 ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА. Все права защищены \*



2 публикации об авторе ссылаются на Scopus Подробнее

Sachuk, N. V.

Samara National Research University, Samara, Russian Federation Показать всю информацию об авторе

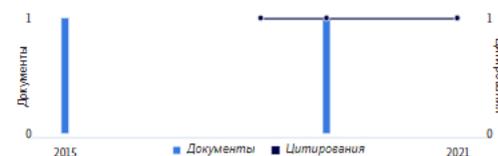
56747828200 Связать с ORCID

- Редактировать профиль
- Настроить оповещение
- Потенциальные соответствия авторов
- Экспортировать в SciVal

Обзор показателей

- 2 Документов по автору
- 3 Цитирования в 3 документах
- 1 h-index: View h-graph

Документ и тенденции цитирования



Анализировать результаты по автору Обзор цитирования

Темы с наибольшим вкладом 2017–2021

Germanium Oxides; Gate Dielectrics; MOSFET  
1 ДОКУМЕНТ

Просмотреть все темы

2 документа Цитирования в 3 документах 0 препринтов 1 соавтор 1 тема 0 выданных грантов

Экспортировать все Добавить все в список

Сортировать по Дата (самые новые)

- Просмотреть список в формате результатов поиска
- Просмотр приставочных ссылок
- Настроить оповещение о документах

Features of MIS Structures with Samarium Fluoride on Silicon and Germanium Substrates

Shalimova, M.B., Sachuk, N.V.

Semiconductors, 2019, 53(2), pp. 229–233

Просмотреть реферат View at Publisher Связанные документы

1 Цитирования

Degradation of the electrical characteristics of MOS structures with erbium, gadolinium, and dysprosium oxides under the effect of an electric field

Shalimova, M.B., Sachuk, N.V.

Semiconductors, 2015, 49(8), pp. 1045–1051

Просмотреть реферат View at Publisher Связанные документы

2 Цитирования



## Сведения об источнике

[Отзыв](#) [Сравнить источники](#)

### Semiconductors

Предыдущее наименование: [Soviet physics Semiconductors](#)

Годы охвата Scopus: с 1996 по настоящий момент

Издатель: Pleiades Publishing

ISSN: 1063-7826 E-ISSN: 1090-6479

Отрасль знаний: [Materials Science: Electronic, Optical and Magnetic Materials](#) [Physics and Astronomy: Atomic and Molecular Physics, and Optics](#)

[Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics](#)

Тип источника: Журнал

[Посмотреть все документы](#)

[Настроить уведомление о документах](#)

[Сохранить в список источников](#) [Source Homepage](#)

CiteScore 2021	1.4
SJR 2021	0.263
SNIP 2021	0.447

CiteScore CiteScore рейтинг и тренды Содержание Scopus

**i** Улучшенная методика расчета CiteScore  
 Рейтинг CiteScore 2021 отражает количество цитирований в 2018-2021 гг. статей, обзоров, материалов конференций, глав книг и информационных документов, опубликованных в 2018-2021 гг., деленное на количество публикаций за 2018-2021 гг. [Подробнее](#)

CiteScore 2021

$$1.4 = \frac{1\,890 \text{ цитирований за } 2018 - 2021 \text{ гг.}}{1\,305 \text{ документов за } 2018 - 2021 \text{ гг.}}$$

CiteScoreTracker 2022

$$1.4 = \frac{1\,379 \text{ цитирований на текущую дату}}{954 \text{ документов на текущую дату}}$$